

小型・大電流パワーMOSFET EETMOS[®]5 / EETMOS[®]6シリーズ



本シリーズは、従来のEETMOS[®]3 / EETMOS[®]4シリーズのトレンチゲート構造を大幅に改善し、低Qg・低ノイズを実現しました。
また、従来のEETMOS[®]4シリーズでも実績のあるCuクリップ構造の採用などにより、Ron・A比較で約49%低減しております。

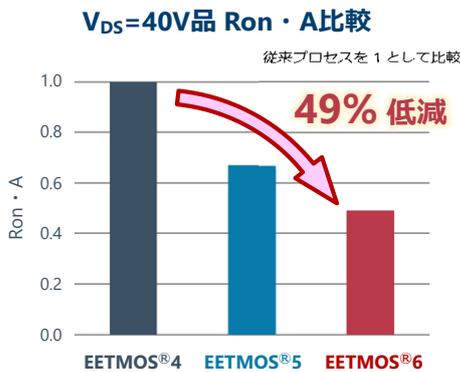


Part Name	V _{DS} min [V]	I _D max [A]	V _{TH} typ [V]	Ron [mΩ] V _{GS} =10V		Ciss [pF] V _{DS} =25V(typ)	Coss [pF] V _{DS} =25V(typ)	Crss [pF] V _{DS} =25V(typ)	Status
				typ	max				
P180LF4RMK	40	180	3.0	0.67	0.84	6754	2165	70	RS
P168LF6RMK	60	168	3.0	1.09	1.29	5133	1728	117	Planning
P85LF10RNK	100	85	3.0	3.2	4.0	3409 ^{*1}	833 ^{*1}	15 ^{*1}	Planning
P58LF15RNK	150	58	3.0	6.8	8.5	TBD	TBD	TBD	Planning
P32LF20GNK	200	32	3.0	23	29	2152 ^{*2}	147 ^{*2}	6 ^{*2}	Planning

*1 : V_{DS}=50V
*2 : V_{DS}=100V

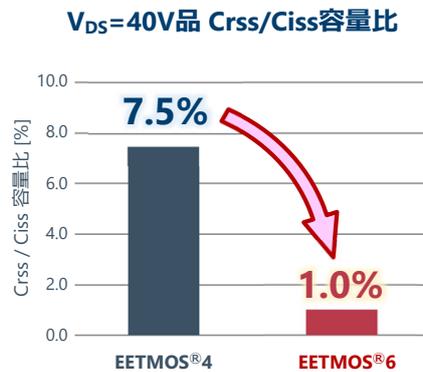
従来品とのRon・A比較

低Ron効果により低損失・高効率を実現しました。



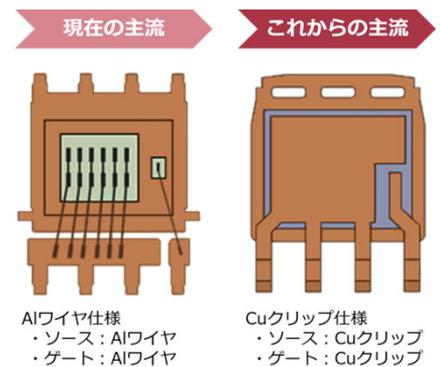
従来品との容量比比較

Crss/Ciss特性を改善し、セルフターンオンのリスクを大幅に低減しました。



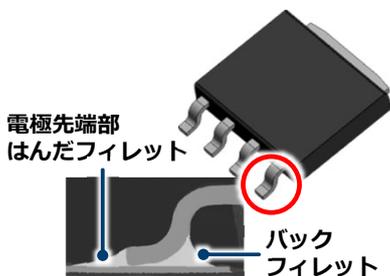
Cuクリップ構造採用

大幅な低抵抗化・放熱性向上で、小型化・オン抵抗の削減を実現しました。



ガルウィング形状のリード

基板応力緩和とはんだ濡れ視認性向上で高信頼性実装を実現しました。



新電元半導体製品の詳細情報はこちら

<https://www.shindengen.co.jp/products/semi/>

